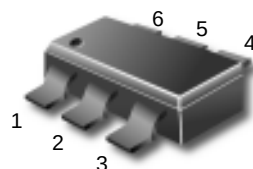


Silicon NPN Epitaxial Planer Transistor

L4501DW1T1

Feature

Pb-Free Package is available.



SC-88/SOT-363

MAXIMUM RATINGS

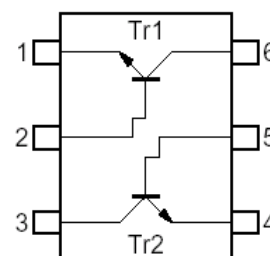
Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7	V
Collector current-continuoun	I_C	150	mAdc

THERMAL CHARATEERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board, (1) $T_A=25^{\circ}\text{C}$	P_D	380	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	328	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction and Storage Temperature	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^{\circ}\text{C}$

DEVICE MARKING

L4501DW1T1=5H



ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
----------------	--------	-----	-----	-----	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage ($I_C=1\text{mA}$)	$V_{(BR)CEO}$	50	-	-	V
Emitter-Base Breakdown Voltage ($I_E=50\text{ }\mu\text{A}$)	$V_{(BR)EBO}$	7	-	-	V
Collector-Base Breakdown Voltage ($I_C=50\text{ }\mu\text{A}$)	$V_{(BR)CBO}$	60	-	-	V
Collector Cutoff Current ($V_{CB}=60\text{V}$)	I_{CBO}	-	-	0.1	μA

L4501DW1T1

EMITTER CUTOFF CURRENT VEB=7V	IEBO	-	-	0.1	μ A
----------------------------------	------	---	---	-----	-----

ON CHARACTERISTICS

DC Current Gain (IC=1mA, VCE=6.0V)	Hfe	120	-	560	
Collector-Emitter Saturation Voltage (IC=50mA, IB=5mA)	VCE(SAT)	-	-	0.4	V

SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS

Current-Gain-Bandwidth Product (VCE = 12.0V; IE =-2.0 mA, f=100MHZ)	Ft	-	180	-	MHz
Output Capacitance(VCE=12V, f=1.0MHz)	Cobo	-	2	3.5	Pf

ORDERING INFORMATION

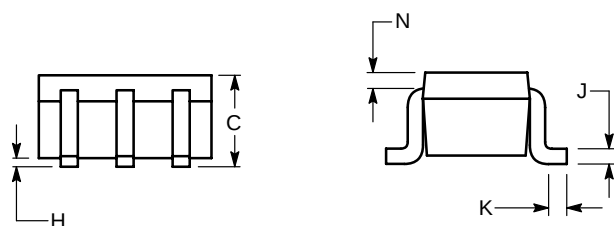
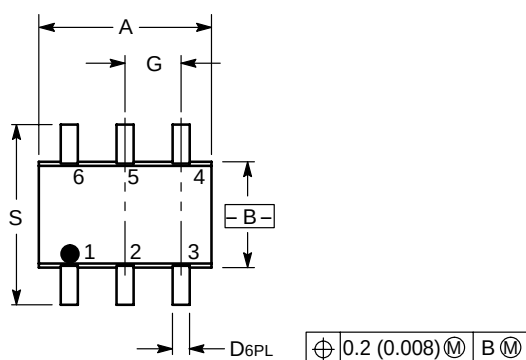
Device	Marking	Shipping
L4501DW1T1	5H	3000/Tape&Reel
L4501DW1T1G	5H (Pb-Free)	3000/Tape&Reel

L4501DW1T1

SC-88/SOT-363

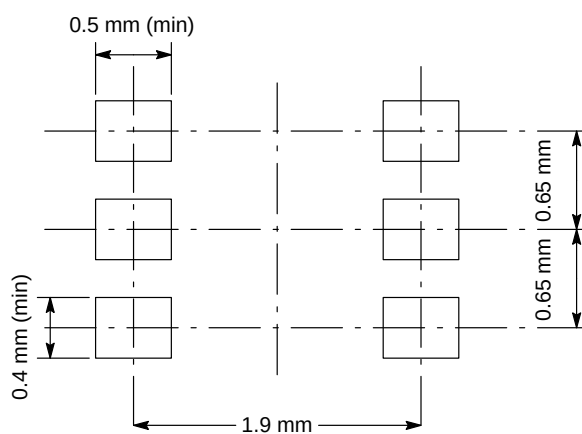
NOTES:

1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.



DIM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.071	0.087	1.80	2.20
B	0.045	0.053	1.15	1.35
C	0.031	0.043	0.80	1.10
D	0.004	0.012	0.10	0.30
G	0.026 BSC		0.65 BSC	
H	---	0.004	---	0.10
J	0.004	0.010	0.10	0.25
K	0.004	0.012	0.10	0.30
N	0.008 REF		0.20 REF	
S	0.079	0.087	2.00	2.20

- PIN 1. EMITTER 1
 2. BASE 1
 3. COLLECTOR 2
 4. EMITTER 2
 5. BASE 2
 6. COLLECTOR 1



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9